

КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г, КТ817Б2, КТ817Г2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,7 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод «Искра», г. Ульяновск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ, не менее:

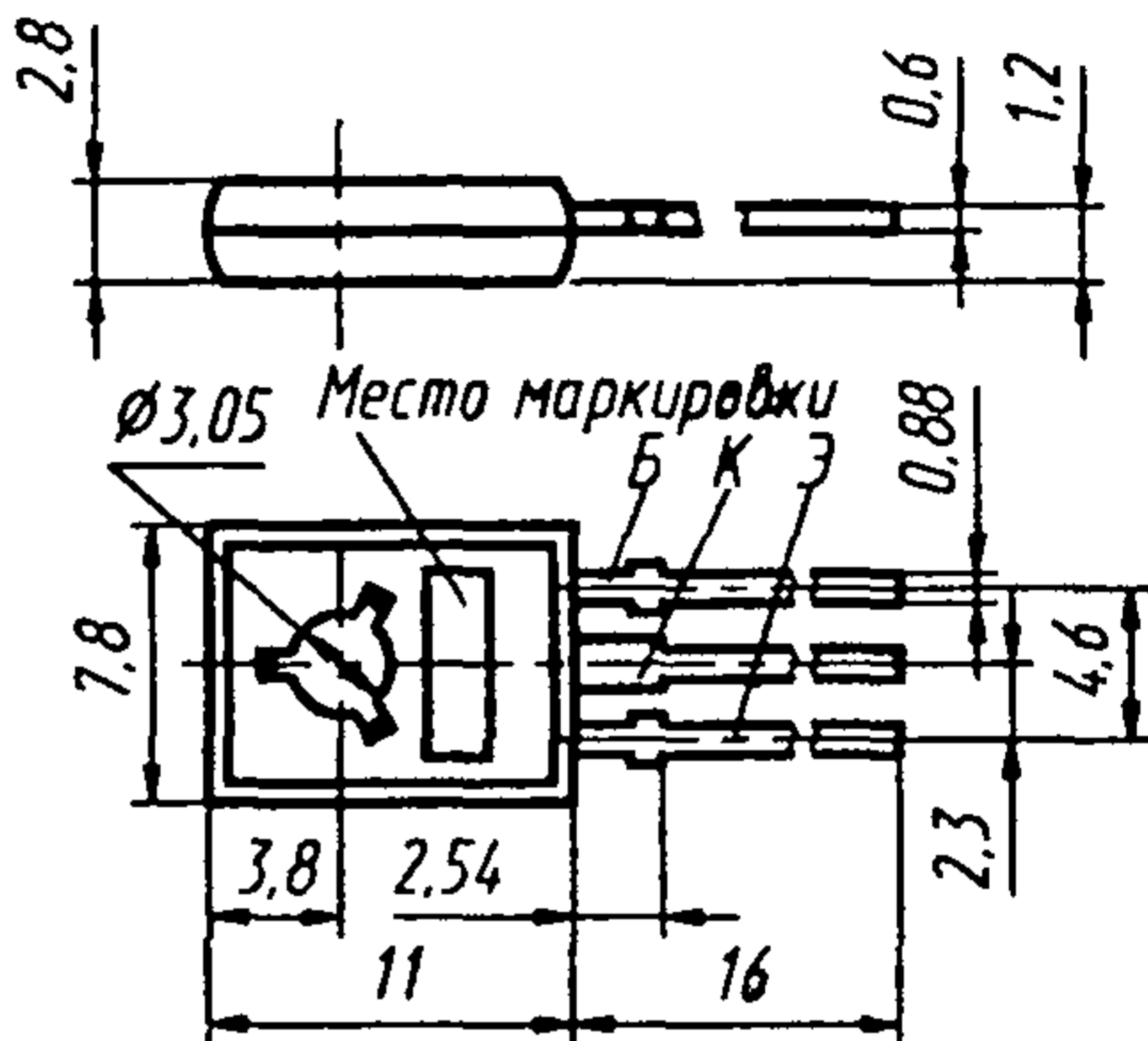
КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г

при $U_{кз} = 2$ В, $I_k = 1$ А:

$T = +25$ и $+100$ °С 25

$T = -40$ °С 15

КТ817(А-Г), КТ817(Б2, Г2)



КТ817Б2, КТ817Г2 при $U_{кз} = 5$ В, $I_k = 50$ мА	100
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 0,25$ А, не менее	3 МГц
Граничное напряжение при $I_3 = 100$ А, $t_H = 300$ мкс, $Q = 100$, не менее:	
КТ817А	25 В
КТ817Б, КТ817Б2	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В
КТ817Г2	90 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:	
КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г при $I_k = 1$ А, $I_б = 0,1$ А, не более	0,6 В
типовое значение	0,15* В
КТ817Б2, КТ817Г2 при $I_k = 1,5$ А, $I_б = 0,15$ А, не более	0,12 В
Напряжение насыщения база—эмиттер:	
КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г при $I_k = 1$ А, $I_б = 0,1$ А, не более	1,5 В
КТ817Б2, КТ817Г2 при $I_k = 1,5$ А, $I_б = 0,15$ А, не более	1,5 В
Пробивное напряжение база—эмиттер при $I_{эб0} = 1$ мА, не менее	5 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кз р, макс}$, не более:	
$T = +25$ и -40 °С	100 мкА
$T = +100$ °С	3000 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	60 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, не более	115 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
$R_{бэ} = \infty$:	
КТ817А	25 В
КТ817Б, КТ817Б2	45 В
КТ817В	60 В
КТ817Г	80 В
КТ817Г2	90 В
$R_{бэ} = 1$ кОм:	
КТ817А	40 В
КТ817Б, КТ817Б2	45 В

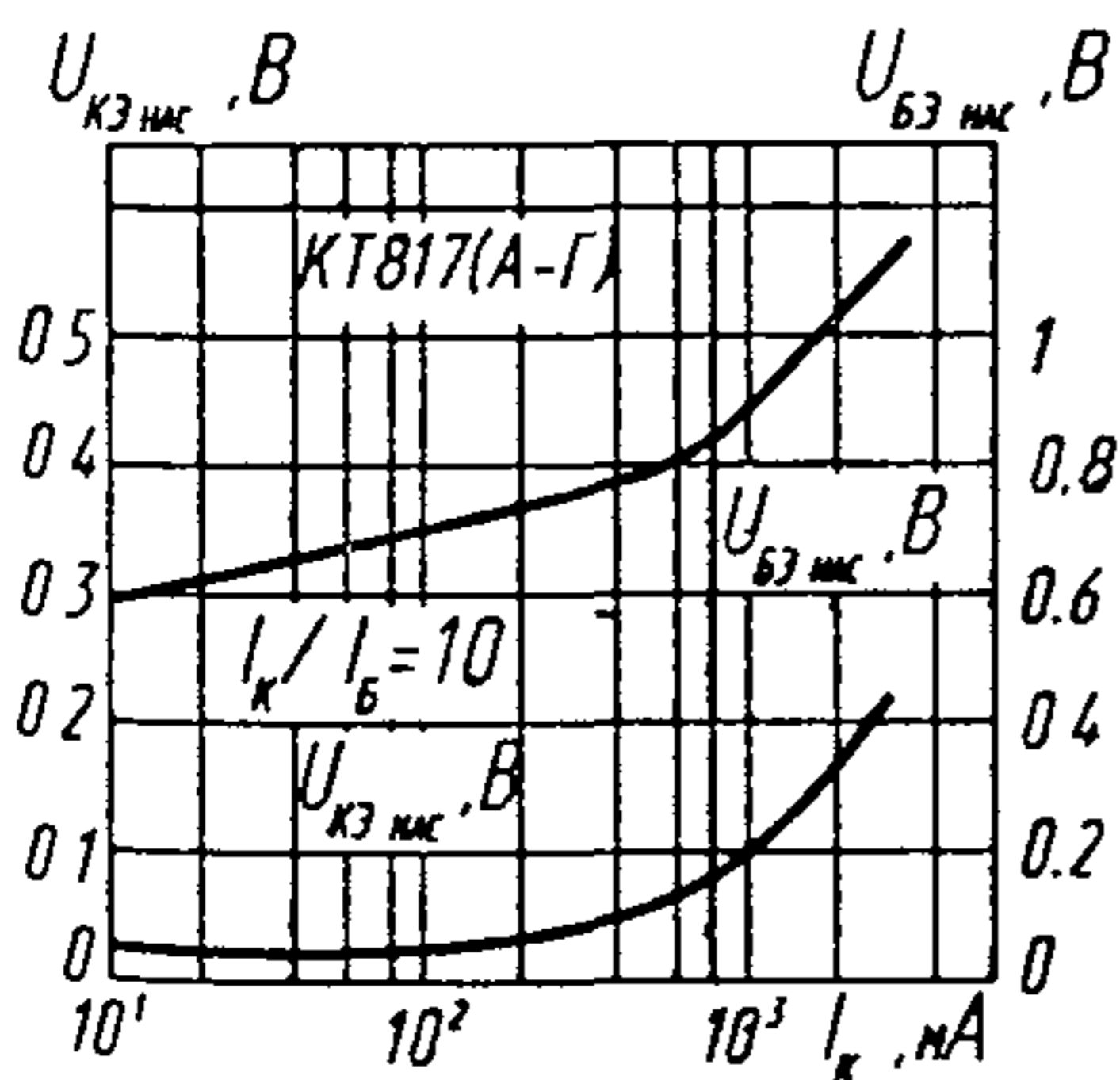
КТ817В	60 В
КТ817Г, КТ817Г2	100 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	3 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 20$ мс, $Q = 100$	6 А
Постоянный ток базы	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $T_{к} = -60...+25$ °С:	
с теплоотводом	25 Вт
без теплоотвода	1 Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-40... $T_{к} =$ = +100 °С

¹ При $T_{к} > +25$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно на 0,2 Вт/°С с теплоотводом и на 0,1 Вт/°С без теплоотвода.

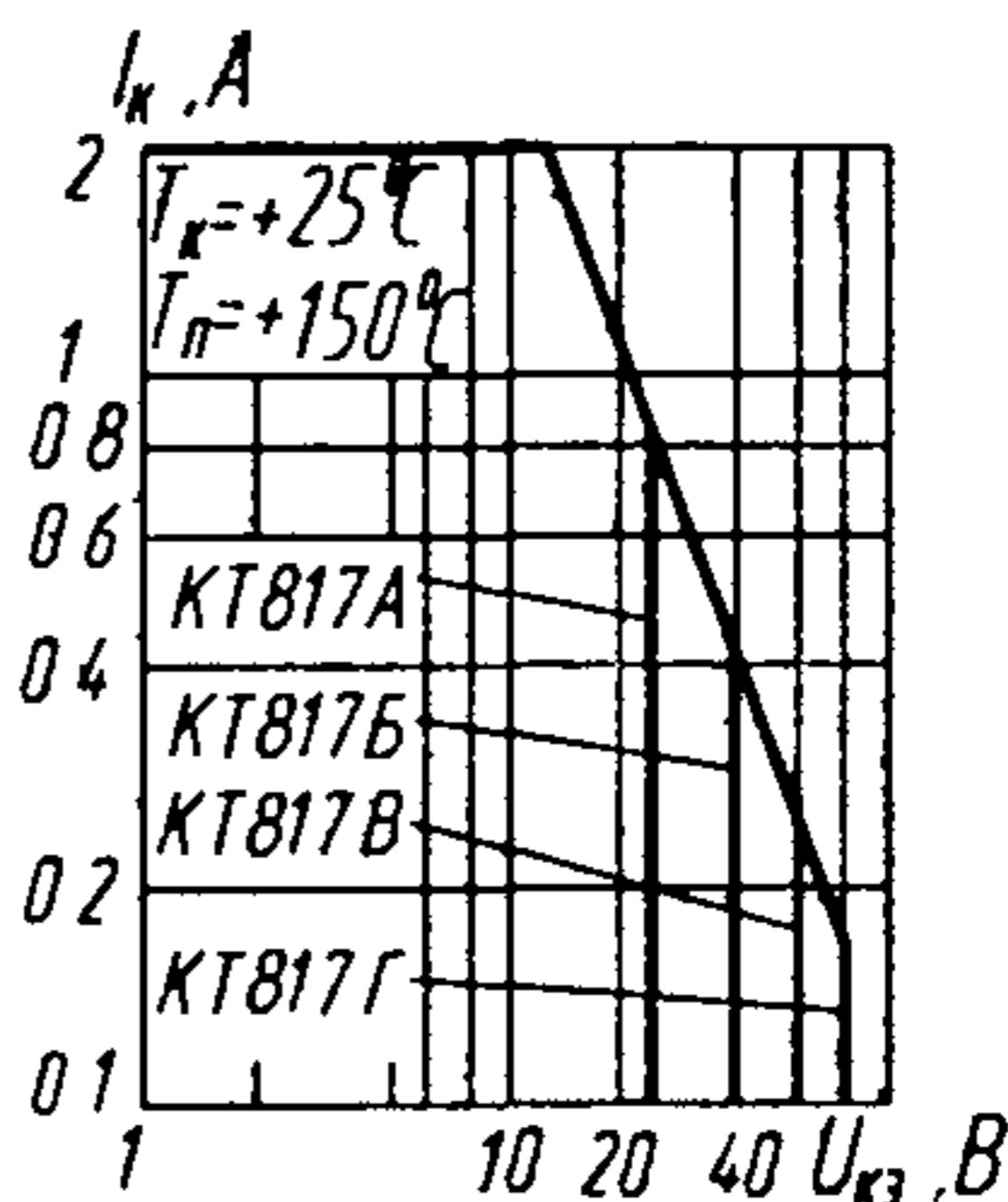
Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

При монтаже транзистора на теплоотвод крутящий момент при нажатии не должен превышать 70 Н·см.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса.

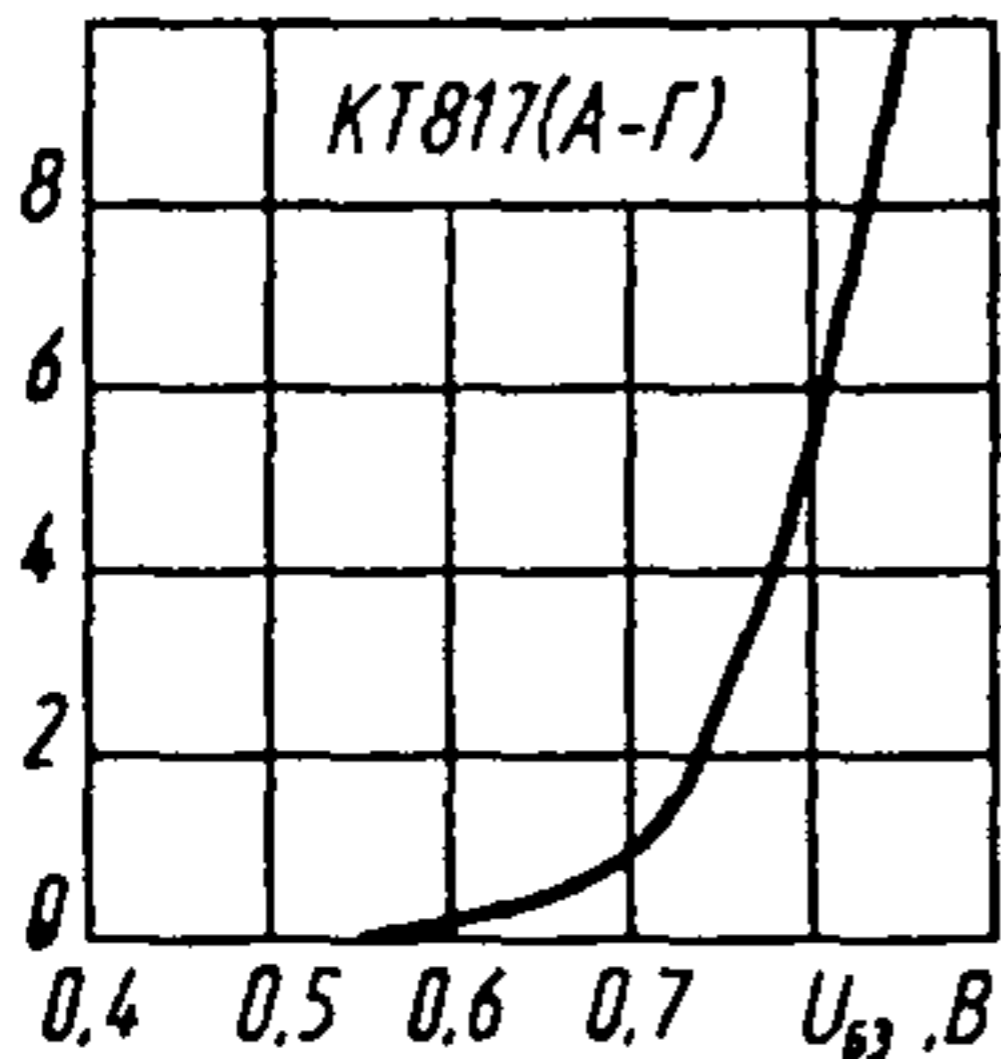


Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора



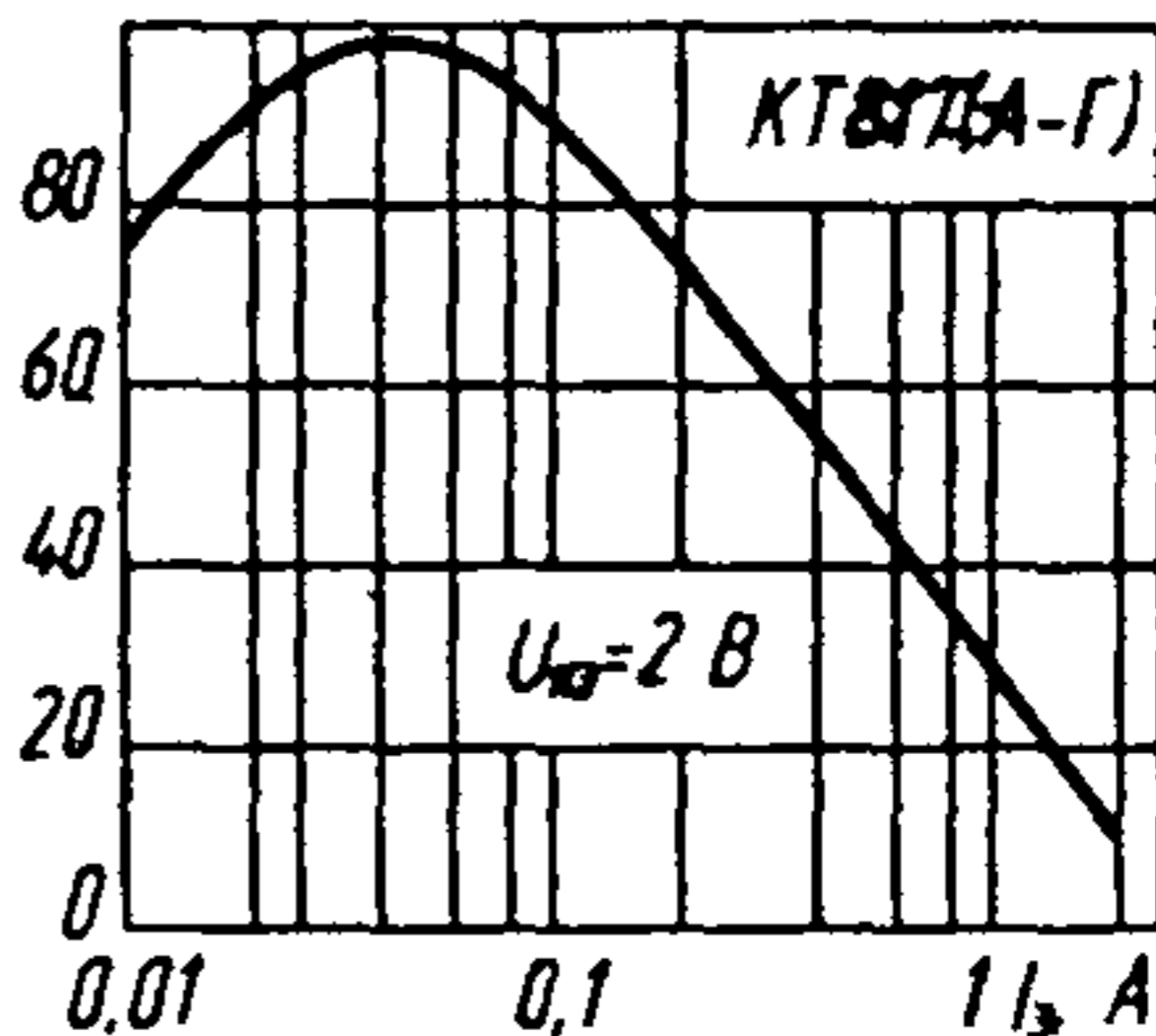
Области максимальных режимов

I_{cM}



Входная характеристика

$h_{гг}$



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера